

“九五”国家重点图书

材料科学与工程系列教材

根据 1998 年教育部颁布本科最新专业目录编写

殷景华 王雅珍 鞠刚 主编
杨尚林 顾大明 主审

功能材料概论

哈尔滨工业大学出版社

“九五”国家重点图书

功能材料概论

殷景华 王雅珍 鞠 刚 主编
杨尚林 顾大明 主审

哈尔滨工业大学出版社
哈尔滨

内 容 简 介

本书由五大部分组成。第一部分是功能材料的科学基础,包括晶体学基础及材料性能、高分子基础;第二部分是金属功能材料,包括超导材料、贮氢合金、形状记忆合金、非晶态合金、磁性材料;第三部分是无机非金属功能材料,包括半导体材料、光学材料、精细功能陶瓷、功能转换材料;第四部分是功能高分子材料,包括高分子试剂及固相合成、高分子催化剂、固定化酶及高分子螯合剂、感光及导电性高分子材料、高分子药物;第五部分是低维功能材料,包括功能薄膜材料、新型功能材料等。

本书可作为高等学校材料学科各专业本科生教材,亦可作为研究生教学参考书,也可供从事材料研究与应用工作的科技人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

功能材料概论/殷景华主编.—2版.—哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2002.9

材料科学与工程系统教材(一)

ISBN 7-5603-1384-1

I.功… II.殷… III.工程材料-概论
IV.TB3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 039819 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
印 刷 哈尔滨市龙华印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 17.75 字数 405 千字
版 次 2002 年 9 月第 2 版 2004 年 3 月第 5 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-1384-1/TG·45
印 数 13 001~17 000
定 价 19.80 元

材料科学与工程系列教材(一)

总主编 曹茂盛 李大勇 荆天辅
总主审 李庆芬 廖波 张宝生

材料科学与工程系列教材(一) 总编审委员会

主任委员 曹茂盛
副主任委员 张宝生 张显友 荆天辅
委 员 (按姓氏笔画排序)
邓启刚 王荣国 李大勇 李庆芬
孙德智 谢辅洲 陈平 杨尚林
张德庆 姜兆华 赵品 常铁军
戴金辉 廖波

序 言

材料科学与工程系列教材是由哈尔滨工业大学出版社组织国内部分高校专家学者共同编写的一套大型系列教学丛书,被列入“九五”国家重点图书出版规划。编写本套丛书的基本指导思想是:总结已有、通向未来、面向 21 世纪,以优化教材链为宗旨,依照为培养材料科学人才提供一个捷径的原则,确定培养目标、编写大纲、书目及主干内容。为了确保图书品位、体现国家水平,总编审委员会全体成员对国内外同类教材进行了长期细致的调查研究,广泛征求各参编院校第一线任课教师的意见,认真分析国家教育部新的学科专业目录和全国材料工程类专业教学指导委员会第一届全体会议的基本精神,进而制定了具体的编写大纲。经过全体编审人员的共同努力,现在这套教材即将出版发行,我们热切期望这套大型系列教学丛书能够满足国内高等院校材料工程类专业教育发展的需要,并且在教学实践中得以不断充实、完善和发展。

在本书的编写过程中,注意突出了以下几方面特色:

1. 根据科学技术发展的最新动态和我国高等学校学科归并的现实需求,坚持了加强基础、拓宽专业面、更新教材内容的基本原则。
2. 注重优化课程体系,探索教材新结构,即兼顾材料工程类学科中金属材料、无机非金属材料、高分子材料、复合材料共性与个性的结合,实现多学科知识的交叉与渗透。
3. 反映当代科学技术的新概念、新知识、新理论、新技术、新工艺,突出反映教材内容的现代化。
4. 坚持体现教材内容深广度适中,够用为原则,增强适用性。
5. 在系列教材编写过程中,进行了国内外同类教材对比研究,吸取了国内外同类教材的精华,重点反映新教材体系结构特色,把握教材的科学性、系统性和适用性。

此外,本套系列教材还兼顾了内容丰富、叙述深入浅出、简明扼要、重点突出等特色,能充分满足少学时教学的要求。

参加本套系列教学丛书编审工作的单位有:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、燕山大学、哈尔滨建筑大学、哈尔滨理工大学和齐齐哈尔大学等六所院校 50 余名专家学者,他们为本套系列教材编审付出了大量的心血,在此,总编审委员会对这些同志无私的奉献致以崇高的敬意。在本套系列教材编审的过程中,得到了全国材料工程类专业教学指导委员会主任吴林教授和哈尔滨工业大学材料科学与工程学院副院长方洪渊教授的指导,中国工程院雷廷权院士应邀出席了本套系列教材的终审讨论会,并就学科建设、课程建设及教材建设提出了许多宝贵意见。在此,一并表示衷心的感谢。

限于编审者的水平,疏漏和不妥之处在所难免,欢迎同行和读者指正。

材料科学与工程系列教材
总编审委员会
1999 年元月

再版前言

能源、信息和材料是现代文明的三大支柱,而材料又是一切技术发展的物质基础。功能材料是指具有特定光、电、磁、声、热、湿、气、生物等特性的各类材料。这些材料在能源、计算技术、通信、电子、激光、空间、医药等现代技术中有着广泛的应用。

材料科学的迅速发展,要求即将成为材料工作者的在校本科生、研究生有一个较高的学习起点,掌握这一领域的基本知识、概念和方法,并能够独立地学习和掌握更多的知识,能够接触一些材料科学前沿领域和新的进展。本书是在这种思想指导下,根据国家教育部 1998 年调整的最新专业目录和全国材料工程类专业教学指导委员会的精神,为材料科学与工程专业学生编写的教科书。

本书是作者在使用多年功能材料讲义的基础上,修改补充而成的。全书共分 18 章,分别介绍了超导、贮氢合金、形状记忆合金、非晶态合金、磁性材料、半导体材料、微电子器件材料、光学材料、功能陶瓷、纳米材料、功能转换材料、高分子试剂、高分子催化剂、高分子螯合剂、感光导电性高分子、功能薄膜、新型功能材料等内容。

我们希望通过上述内容的介绍,使读者对功能材料的性能、制备、应用有一定的了解和掌握。

本书第 1 章、第 8~13 章、第 17~18 章由殷景华编写,第 2 章、第 14~16 章由王雅珍编写,第 3~7 章由鞠刚编写。本书第 1~2、14~16 章由顾大明主审,第 3~13 章、17~18 章由杨尚林主审。

由于时间仓促,编者学识、水平有限,书中不当之处在所难免,诚恳欢迎读者批评指正。

编者
2002 年 7 月

来信请寄哈尔滨工业大学出版社 张秀华(收)
地址:哈尔滨市南岗区教化街 21 号
邮编:150001

目 录

第 1 章 晶体学基础及材料性能	1
1.1 晶体特征	1
1.2 化学键与晶体类型	3
1.3 晶体结构	4
1.4 晶体缺陷	7
1.5 导体、半导体和绝缘体	8
1.6 功能材料的性能	10
第 2 章 高分子基础	13
2.1 高分子的概念	13
2.2 合成高分子的化学反应	16
2.3 高聚合物的分类和命名	18
2.4 高分子材料的特性	20
2.5 高聚物的溶解过程及溶液性质	22
第 3 章 超导材料	23
3.1 超导的微观图像	23
3.2 超导体的临界参数	26
3.3 低温超导材料	27
3.4 超导材料的应用	30
第 4 章 贮氢合金	33
4.1 金属贮氢原理	33
4.2 贮氢合金分类	36
4.3 贮氢合金的应用	41
第 5 章 形状记忆合金	46
5.1 形状记忆原理	46
5.2 形状记忆合金材料	50
5.3 形状记忆材料的应用	56
第 6 章 非晶态合金	59
6.1 非晶态合金的结构	59
6.2 非晶态材料的制备	61
6.3 非晶态合金材料	67
6.4 非晶态合金的性能及应用	67
第 7 章 磁性材料	74
7.1 软磁材料	74
7.2 硬磁材料	80

7.3	磁记录材料	87
7.4	其他磁性材料	92
第8章	半导体材料	96
8.1	半导体材料分类	96
8.2	硅和锗半导体材料	97
8.3	化合物半导体材料	99
8.4	半导体微结构材料	103
8.5	非晶态半导体	107
8.6	半导体光电子材料	111
8.7	半导体陶瓷	112
第9章	微电子器件材料	116
9.1	集成电路概述	116
9.2	衬底材料	116
9.3	互连材料	117
9.4	光刻掩膜版材料	118
9.5	基板材料	119
9.6	封装材料	120
9.7	多芯片组件材料	122
第10章	光学材料	123
10.1	激光材料	123
10.2	光纤材料	126
10.3	红外材料	131
10.4	发光材料	132
10.5	光色材料	138
10.6	非线性光学材料	140
10.7	液晶材料	142
第11章	精细功能陶瓷	146
11.1	导电陶瓷	146
11.2	介电铁电陶瓷	147
11.3	气敏陶瓷和湿敏陶瓷	151
11.4	铁氧体	154
11.5	生物陶瓷	155
11.6	高温超导陶瓷	157
第12章	纳米材料	161
12.1	纳米材料分类	161
12.2	纳米材料特性	161
12.3	纳米材料制备	163
12.4	纳米磁性材料	164

12.5	纳米陶瓷材料	165
12.6	纳米碳分子材料	165
第 13 章	功能转换材料	169
13.1	压电材料	169
13.2	热释电材料	171
13.3	光电材料	174
13.4	热电材料	176
13.5	电光材料	178
13.6	磁光材料	180
13.7	声光材料	183
第 14 章	高分子试剂及固相合成	185
14.1	高分子试剂的特点	185
14.2	高分子氧化试剂	186
14.3	高分子还原试剂	190
14.4	氧化还原树脂	193
14.5	高分子转递试剂	197
14.6	高分子偶合剂	201
14.7	高分子载体上的固相合成	202
第 15 章	高分子催化剂、固定化酶及高分子螯合剂	213
15.1	高分子催化剂和固定化酶	213
15.2	高分子螯合剂	221
第 16 章	感光及导电性高分子	233
16.1	感光性高分子材料	233
16.2	导电性高分子材料	239
第 17 章	功能薄膜材料	246
17.1	薄膜制备技术	246
17.2	导电薄膜	249
17.3	光学薄膜	251
17.4	磁性薄膜	253
17.5	高温超导薄膜	255
17.6	离子交换膜	257
第 18 章	新型功能材料	260
18.1	智能功能材料	260
18.2	梯度功能材料	262
18.3	功能复合材料	264
18.4	多孔硅材料	267
	参考文献	269

第 1 章 晶体学基础及材料性能

1.1 晶体特征

1.1.1 空间点阵

原子或分子结合成金属和陶瓷时,形成晶体。在晶体中,原子和原子集团在三维空间中有规律分布。如果将每一个可重复的单位用一个点来表示,就能形成一个有规则的三维点阵,称为空间点阵。图 1-1 表示了二维晶体结构和空间点阵示意图。为了便于分析各种晶体中原子排列的规律,空间点阵常用空间格子来表示,见图 1-2(a),这种空间格子称为晶格。由于晶格具有周期性,可取一单位体积(平行六面体)作为重复单元,来概括整个晶格的特征。这样选取的重复单元称为原胞,见图 1-2(b)。

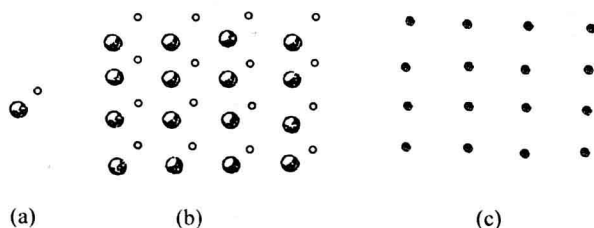


图 1-1 二维晶体结构和空间点阵示意图

(a)包含两种原子的结构单元; (b)晶体结构; (c)空间点阵

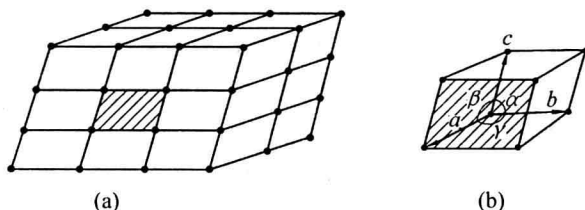


图 1-2 晶格和原胞

空间点阵就其对称性,可以分为十四种类型,见图 1-3,隶属于七个晶系。

1.1.2 晶面指数

在晶体中,为了表达与晶轴相关的晶面方向或晶向,常使用三个整数,称为密勒指数。如图 1-4 所示,设有一晶面与 a, b, c 轴交于 M_1, M_2, M_3 三点,通过求出三个截距值倒数的最小整数比,即可得到该晶面的晶面指数(236)。图 1-5 中标出了晶体中一些晶面的密

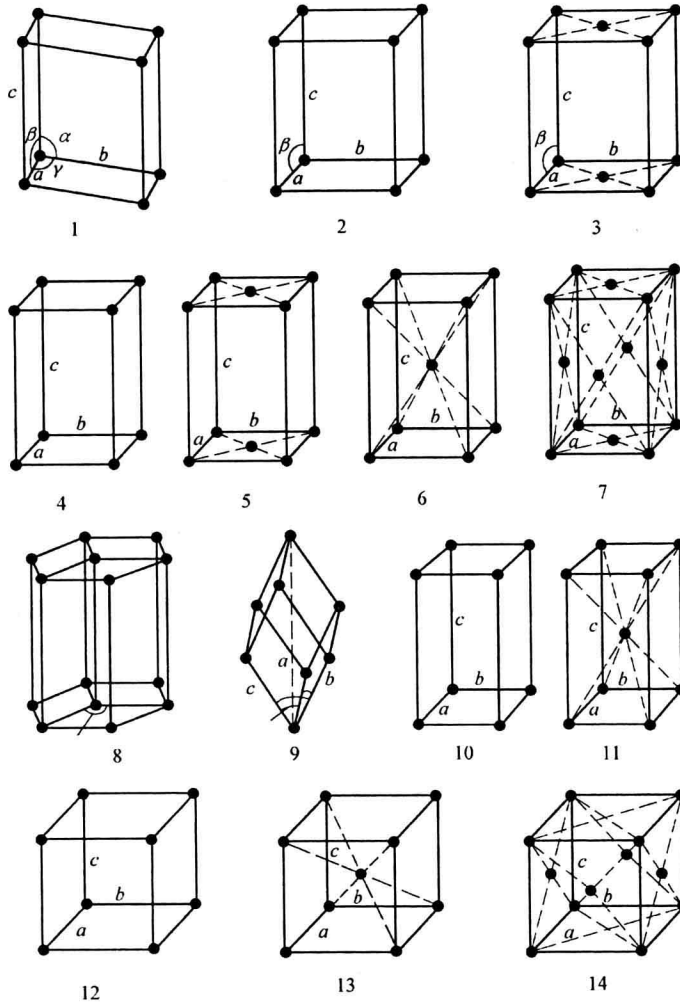


图 1-3 14 种布喇菲点阵的晶胞

- 1—简单三斜;2—简单单斜;3—底心单斜;4—简单正交;5—底心正交;
 6—体心正交;7—面心正交;8—简单六方;9—简单菱形;10—简单正方;
 11—体心正方;12—简单立方;13—体心立方;14—面心立方

勒指数。密勒指数简单的晶面,如(100)、(110),晶面上原子聚集密度较大,晶面之间的距离较大,结合力较弱,易分裂,这样的晶面为解理面。

1.1.3 对称性

晶体具有一定的对称性,晶体的对称性是指晶体经过某些对称操作后仍然能回复原状的特性。基本的对称操作为旋转与反映,对称操作所依赖的几何要素,如点、线、面,称为对称元素。

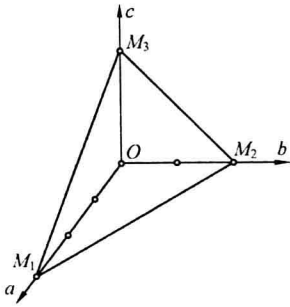


图 1-4 晶面指数

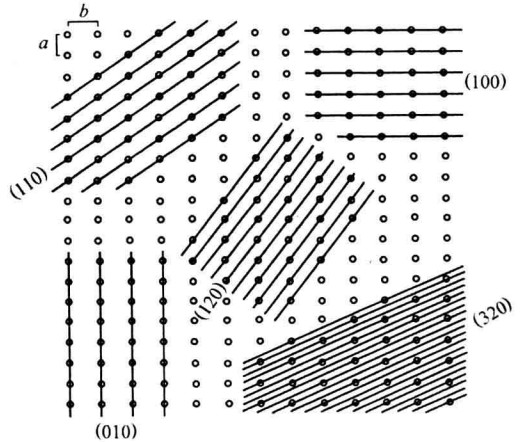


图 1-5 晶面指数与面间距

1.2 化学键与晶体类型

研究表明,当自由原子结合成晶体时,其最外层价电子的分布情况将要发生变化,并由此产生不同类型的结合力,晶体的结构和性质则主要决定于组成晶体的原子结构以及它们之间结合力的性质。

1.2.1 离子键与离子晶体

原子间最简单的作用力是离子键,它产生于正、负电荷之间的静电引力,典型的离子晶体是元素周期表中ⅠA族的碱金属元素Li,Na,K,Rb,Cs和ⅦA族的卤族元素F,Cl,Br,I之间形成的化合物晶体。这种晶体是以正、负离子为结合单元的,最典型的结构有两种:一种是NaCl型结构,配位数为6;另一种是CsCl型结构,配位数为8。离子晶体结构稳定,结合能较大,具有导电性差、熔点高、硬度高和膨胀系数小等特点。大多数离子晶体对可见光是透明的,但在红外区域有一个特征吸收峰。

1.2.2 共价键与原子晶体

在晶体中,一对为两个原子所共有的自旋相反、配对的电子结构称为共价键。共价键有两个基本特点:饱和性和方向性。ⅣA~ⅥA族元素是共价键结合,大多数共价键的最大数目符合 $8-N$ 定则,其中 N 为原子的价电子数目,并且原子总是在其价电子波函数最大的方向上形成共价键。

元素周期表中第ⅣA族元素C(金刚石),Si,Ge,Sn(灰锡)的晶体是这类晶体的典型代表,它们的结构是金刚石结构。共价键结合是一种强的结合,晶体有很高的熔点和硬度,如金刚石是目前所知最硬的晶体,其熔点高达 3550°C 。同时,共价晶体中价电子定域在共价键上,因而其导电性很弱,一般属于绝缘体或半导体。

1.2.3 金属键与金属晶体

金属键的基本特征是电子为晶体共有,即原属于各原子的价电子不再束缚在原子上,可在整个晶体内运动(可视为离域的共价键),原子间结合较强。多数金属晶体以面心立

方排列,配位数为 12。

金属具有良好的导电性、导热性及高延展性,其熔点较高。

1.2.3 范德华力与分子晶体

分子晶体的结合是依靠分子之间的作用力,这种作用力称为范德华力,其作用范围为 0.2~0.5 nm,一般不具有方向性和饱和性。

惰性元素在低温下形成典型非极性分子晶体。Ne, Ar, Kr, Xe 的晶体是面心立方结构。它们是透明的绝缘体,熔点较低,分别为 24K, 84K, 117K 和 161K, 温度升高时,易升华。

1.3 晶体结构

1.3.1 元素的晶体结构

如表 1-1 所示,元素的晶体结构可分三类。周期表左面的元素属于第一类。它们都是金属,具有面心立方、六方和体心立方等密堆积型的晶体结构,见图 1-6。

表 1-1 元素的晶体结构*

IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII	IB	II B	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA		
Li b.	Be c.									B hex	C					
Na b.	Mg c.									Al f.	Si	P	S	Cl		
K b.	Ca f.c.	Sc f.c.	Ti c.	V b.	Cr b.c.	Mn cub	Fe b.f.	Co c.f.	Ni f.c.	Cu f.	Zn hex	Ga orh	Ge	As	Se	Br
Rb b.	Sr f.	Y c.	Zr c.b.	Nb b.	Mo b.	Tc c.	Ru c.	Rh f.cub	Pd f.	Ag f.	Cd hex	In tet	Sn	Sb	Te	I
Cs b.	Ba b.	La c.f.	Hf c.	Ta b.	W b.cub	Re c.	Os c.	Ir f.	Pt f.	Au f.	Hg rho	Tl c.f.	Pb f.	Bi		
			Th f.			U orh										
第一类结构										第二类结构			第三类结构			

*表中, b:体心立方, c:六方密堆积, f:面心立方密堆积, cub:立方, hex:六方, orh:正交, tet:四方, rho:三方,

周期表右面的元素属于第三类结构,它们是非金属。由于形成共价键,这类结构的配位数不超过 8,遵守 8-N 规则, N 为非金属元素在周期表中所处的族数。图 1-7(a)是碘的晶体结构,配位数为 2,形成链状结构;图 1-7(b)是 Te 的结构,配位数为 3,形成层状结构;图 1-7(c)是 As 的结构,配位数为 4,形成三维伸展的网状结构。

处于周期表中间的一些少数元素属于第二类结构。它们之中锌和镉虽属六方结构,但不是密堆积。汞是简单三方结构,镓的结构复杂。具有六方密堆积的 α -Tl,具有面心立方的铅以及具有四方结构的铟,在结构上均相似于金属,但从原子间距上看,结构中却存

在着原子部分离解。硼和锡结构介于第二类和第三类结构之间。

有些元素具有一种以上的结构形式,称其为同素异构体。一种元素是否有同素异构体,如果有,它的每种同素异构体在什么条件下生成,均取决于元素本身特性以外的温度、压力等外部条件。碳可以立方金刚石结构存在,也可以六方石墨结构存在。把石墨变成金刚石需 1 000℃ 以上的高温及巨大压强。铁的情形有所不同,具有体心立方的 α -Fe,在室温稳定存在,当温度升至 906 ~ 1 400℃ 之间,具有面心立方的 γ -Fe 取代了 α -Fe 成为主要晶型;当温度从 1 400℃ 升至熔点 1 535℃ 时,晶型又变回体心立方 δ -Fe。

1.3.2 典型晶体结构

氯化钠 (NaCl) 具有面心立方结构。

每个结构单元含一个钠离子和一个氯离子,该结构可认为是分别由钠离子和氯离子组成的两个相同的面心立方格子,沿体对角线相对位移 1/2 对角线长度套构而成(图 1-8)。属于 NaCl 结构的一些有代表性的晶体见表 1-2,其中 a 为晶格常数。

表 1-2 具有氯化钠结构的晶体

晶体	a/nm	晶体	a/nm
LiH	0.408	AgBr	0.577
NaCl	0.563	MgO	0.422
KCl	0.629	MnO	0.443
PbS	0.592	KBr	0.659

氯化铯 (CsCl) 具有简单立方结构(图 1-9)。铯离子和氯离子分别组成两个相同的简单立方格子,沿体对角线相对位移 1/2 的长度套构而成。具有 CsCl 结构的一些晶体见表 1-3。

金刚石具有面心立方结构,每个结构单元包含两个原子。金刚石结构可认为是由两个相同的面心立方格子,沿体对角线相对位移 1/4 的长度套构而成(图 1-10)。

半导体锗和硅具有金刚石结构,这种结构空隙较大,杂质原子容易在这些材料中扩散,这一特性被应用到半导体器件的制作技术中。

如果把金刚石结构中的两个面心立方晶格上的碳原子,一个换成锌原子,另一个换成硫原子,则形成闪锌矿结构(图 1-11)。一些重要的化合物半导体材料,如砷化镓、锑化铟等晶体都具有闪锌矿结构,而且在 [111] 轴的上下两个方向上,表现出不同性质,其生长速

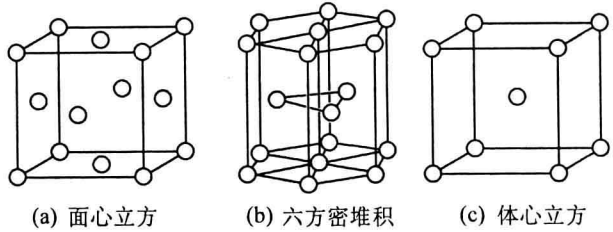


图 1-6 典型密堆积型的金属晶体结构

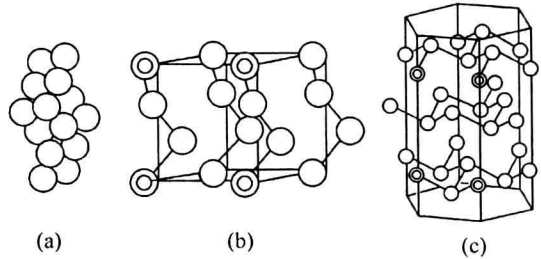


图 1-7 典型非金属的晶体结构

(a) 碘的晶体结构; (b) 碲的晶体结构;

(c) 砷的晶体结构

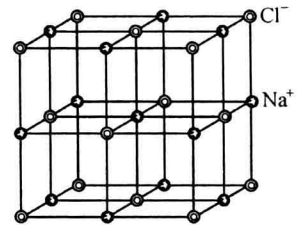


图 1-8 氯化钠晶体结构

率和腐蚀速率不相同(图 1-12)。属于闪锌矿结构的晶体还有 CuF, CuCl, ZnSe, CdS, InAs, SiC 和 AlP。

表 1-3 具有氯化铯结构的晶体

晶体	a/nm	晶体	a/nm
CsCl	0.411	CuZn	0.294
TlBr	0.397	AgMg	0.328
TlI	0.420	LiHg	0.329
NH ₄ Cl	0.387	AlNi	0.288
CuPd	0.299	BeCu	0.270

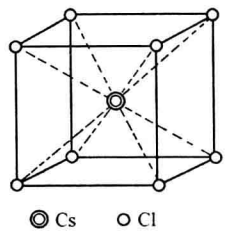


图 1-9 氯化铯晶体结构

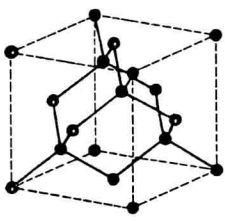


图 1-10 金刚石晶体结构

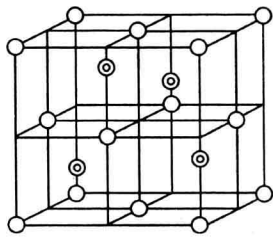


图 1-11 闪锌矿晶体结构

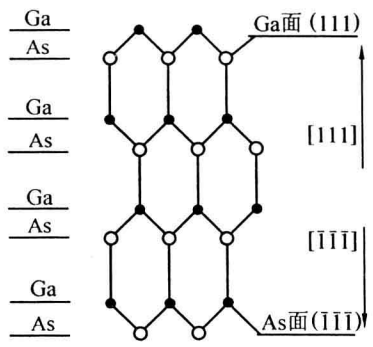


图 1-12 砷化镓晶体的 [111]和[1-1-1]晶向

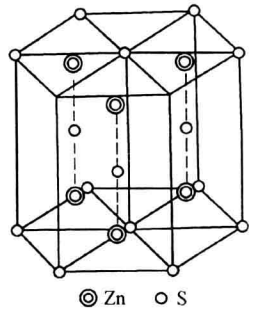


图 1-13 纤维锌矿晶体结构

纤维锌矿晶体结构属于六方晶系,晶格常数为 $a = 0.384 \text{ nm}$, $c = 0.5180 \text{ nm}$ 。在一个结晶学原胞中含有两个 Zn 原子、两个 S 原子,纤维锌矿晶体结构见图 1-13。

在纤维锌矿晶体结构中, S^{2-} 构成六方最紧密堆积,而 Zn^{2+} 占有 1/2 四面体空隙中,两种离子的配位数均为 4。属于纤维锌矿型结构的晶体有 CuBr, CuI, AgI, ZnO, CdS, CdSe, ZnSe, BN, GaN, AlN 等晶体。

萤石 (CaF_2) 晶体属于立方晶系,面心立方晶格,晶格常数 $a = 0.545 \text{ nm}$ 。在一个结晶

学原胞中含有 4 个 Ca 离子和 8 个 F 离子。整个萤石晶体结构可看作是三个相同的面心立方点阵套叠而成,其结构见图 1-14。 Ca^{2+} 的配位数为 8, F^- 的配位数为 4。属于萤石结构的晶体有 BaF_2 , CdF_2 , ZrO_2 , CeO_2 等晶体。

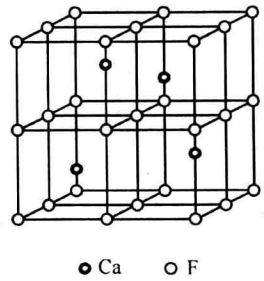


图 1-14 氟化钙晶体结构

钙钛矿(CaTiO_3)型结构是以天然钙钛矿命名的。在钙钛矿结构中, Ca^{2+} 和 O^{2-} 共同构成近似立方最紧密堆积, Ca^{2+} 周围有 12 个 O^{2-} , 每一个 O^{2-} 被 4 个 Ca^{2+} 包围, Ti^{4+} 占据着由 O^{2-} 形成的全部八面体空隙, CaTiO_3 晶体结构见图 1-15。

理想的钙钛矿型结构属立方晶系,但许多属于这种结构的晶体却扭曲为正方、斜方或单斜晶系的晶体,这种扭曲与晶体的压电、热释电和非线性光学性质有着密切的关系,已成为一类十分重要的技术晶体。属于钙钛矿结构的晶体有 BaTiO_3 , PbTiO_3 等。

尖晶石(AB_2O_4)的结构见图 1-16。在尖晶石结构中,能相互代替的三价元素有 Fe^{3+} , Al^{3+} , Cr^{3+} , Mn^{3+} , 二价元素有 Mg^{2+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} 。该晶体属立方晶体,晶胞内含有 8 个分子。在天然矿物中有以下几种尖晶石型矿物: 锌尖晶石(ZnAl_2O_4), 铁尖晶石(FeAl_2O_4), 锰尖晶石(MnAl_2O_4)和镁铁尖晶石 [$\text{Fe}^{3+}(\text{MgFe}^{3+})\text{O}_4$] 等。

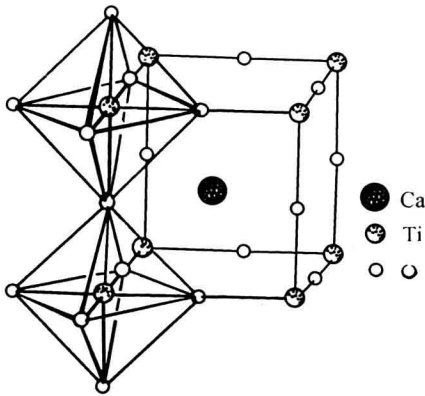


图 1-15 钙钛矿(CaTiO_3)晶体结构模型

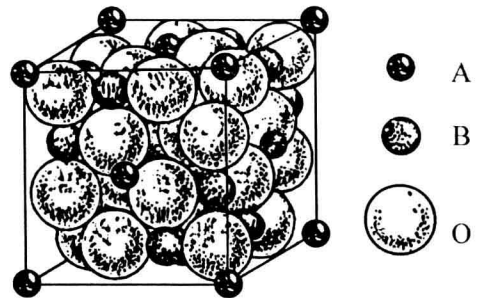


图 1-16 尖晶石的紧密堆积

1.4 晶体缺陷

实际晶体总是有各种缺陷,功能材料的一些性能与这些缺陷密切相关。晶体缺陷按它们的几何形状分为点缺陷、线缺陷和面缺陷。

1.4.1 点缺陷

点缺陷在三维空间中各个方向上的尺寸都很小,如空位、间隙原子、杂质原子等,见图 1-17。半导体材料对杂质非常敏感,其性能可以发生几个数量级的变化。

1.4.2 线缺陷

线缺陷即为位错。晶体中最简单的位错是刃型位错和螺型位错(图 1-18)。晶体中位错的量常用位错密度表示,单位体积中所包含的位错线总长度称为位错密度。位错密度对晶体的机械性能以及某些电学、磁学和光学性能都有显著影响。

1.4.3 面缺陷

主要的面缺陷是表面、界面和堆垛层错。表面层的原子既受到体内原子的束缚,又受环境影响,所以表面的组成和结

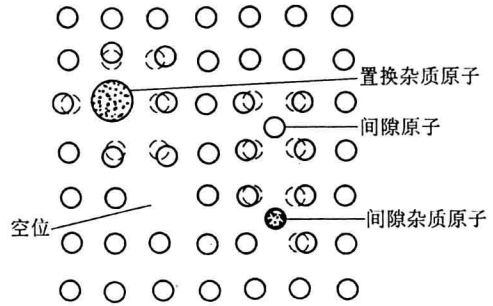


图 1-17 点缺陷示意图

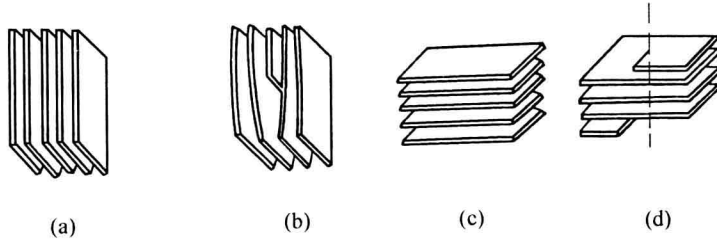


图 1-18 晶体中原子平面示意图

(a)完整晶体; (b)含有刃型位错的晶体; (c)完整晶体; (d)含有螺型位错的晶体

构在很大程度上与形成条件及随后的处理有关,表面对材料和器件的性能影响很大。

多晶体中各晶粒的取向各不相同,不同取向晶粒之间的接触面为晶界,晶界能阻止沿位错的运动。

堆垛层错出现于晶面堆积顺序发生错误的层面,将两个不正确堆垛层面隔开的就是堆垛层错(图 1-19),堆垛层错破坏了晶体的正常周期性,影响材料性能。

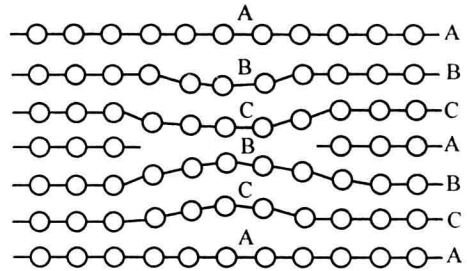


图 1-19 堆垛层错

1.5 导体、半导体和绝缘体

固体中含有大量的电子,但不同固体中的电子导电性相差很大,导体的电阻率在 $10^{-5} \sim 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$,半导体的电阻率在 $10^{-4} \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$,绝缘体的电阻率高达 $10^{10} \sim 10^{22} \Omega \cdot \text{cm}$ 。固体能带理论可以说明导体、半导体和绝缘体的区别。